

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
4. März 2010 (04.03.2010)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2010/022849 A3

(51) Internationale Patentklassifikation:

H01L 27/142 (2006.01) H01L 31/20 (2006.01)
H01L 31/048 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2009/005653

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. August 2009 (05.08.2009)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
08015378.6 1. September 2008 (01.09.2008) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **MERCK PATENT GMBH** [DE/DE]; Frank-
furter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **DOLL, Oliver**
[DE/DE]; Hohebergstrasse 1, 63150 Heusenstamm (DE).
KOEHLER, Ingo [DE/DE]; Dilshoferstrasse 29, 64354
Reinheim (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **MERCK PATENT GMBH** et
al.; Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,
KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,
NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

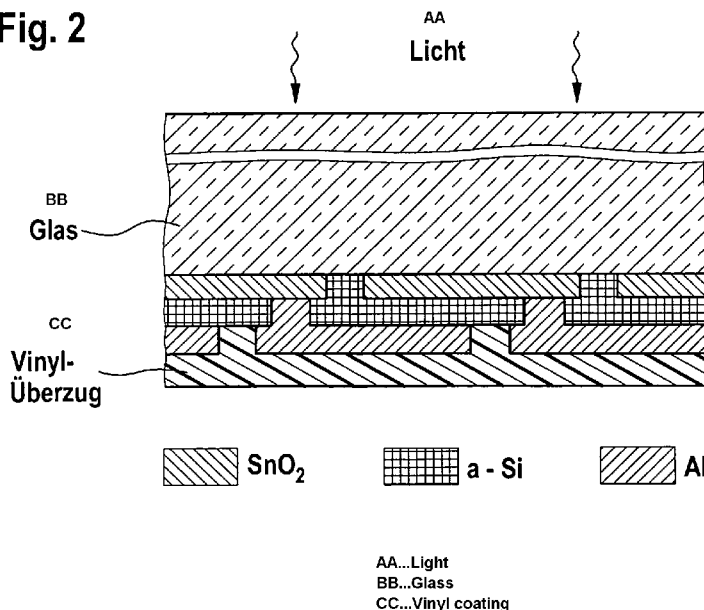
mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: EDGE DELAMINATION OF THIN-LAYER SOLAR MODULES BY MEANS OF ETCHING

(54) Bezeichnung : RANDENTSCHICHTUNG VON DÜNNESCHICHT-SOLAR-MODULEN MITTELS ÄTZEN

Fig. 2



(57) Abstract: The present invention relates to a rapid and low-cost method, which can be carried out locally, for the wet-chemical edge delamination of "solar modules", in which etching pastes which are suited for this purpose are applied and removed once the reaction of the paste remains is completed or the substrate surface is cleaned in a suitable manner. The method uses a newly developed etching paste for such purpose.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein schnelles und kostengünstiges lokal durchführbares Verfahren zur nasschemischen Randentschichtung von "Solarmodulen", indem für diesen Zweck geeignete Ätzpasten aufgetragen und nach erfolgter Reaktion die Pastenreste entfernt werden bzw. die Substratoberfläche in geeigneter Weise gereinigt wird. In dem Verfahren wird eine für den Zweck neu entwickelte Ätzpaste eingesetzt.



— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:

21. Oktober 2010